

Индивидуальная Корзина Для Очистки Полупроводниковых Пластин Из Птфэ, Коррозионностойкая Лабораторная Стойка С Низким Фоновым Уровнем

Артикул: PL-CP267



введение

Достигните высочайшей чистоты в производстве полупроводников с нашими индивидуальными корзинами для очистки из ПТФЭ. Разработанные для обеспечения экстремальной химической стойкости и низкого фонового \square , эти прочные стойки гарантируют эффективную обработку пластин, быстрый сток и надежную работу в критических высокочистых лабораторных условиях.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Процесс очистки по методу RCA	Используется во время последовательностей SC-1 и SC-2 для удаления органических остатков и металлических загрязнений с кремниевых пластин.	Предотвращает повторное загрязнение благодаря сверхчистой поверхности материала с низким выщелачиванием.
Травление в растворе Пираня	Фиксация пластин в смеси серной кислоты и перекиси водорода для удаления фоторезиста.	Выдающаяся стойкость к агрессивным окислительным средам без структурной деградации.
Обработка в плавиковой кислоте	Удаление слоев естественного оксида с кремниевых подложек с использованием концентрированных или буферных растворов HF.	Полная устойчивость к воздействию HF, гарантирующая долгий срок службы оборудования и чистоту процесса.
Промывка после ХМП	Очистка пластин после химико-механической полировки для удаления частиц шлама и химикатов.	Быстрый сток и неприлипающие свойства предотвращают адгезию частиц шлама к корзине.
Разработка фотолитографии	Поддержка подложек во время проявки и удаления слоев фоторезиста.	Высокая размерная стабильность гарантирует точное выравнивание и обработку на критических этапах литографии.
Подготовка к анализу следовых примесей	Очистка лабораторной посуды и контейнеров, используемых в ICP-MS и других высокочувствительных аналитических методах.	Чрезвычайно низкий фоновый уровень гарантирует максимальную точность при обнаружении следовых металлических примесей.
Обработка пластин GaAs	Фиксация пластин сложных полупроводников во время специализированных циклов травления и промывки.	Мягкие опорные конструкции предотвращают разрушение хрупких материалов сложных полупроводников.
Ультразвуковая очистка	Используется в качестве погружного носителя во время циклов высокочастотной акустической очистки.	Эффективно передает ультразвуковую энергию, одновременно защищая пластины от механического контакта с резервуаром.
Особенность	Детали спецификации для PL-CP267	
Идентификатор модели	PL-CP267	
Основной материал	Высокочистый первичный ПТФЭ (политетрафторэтилен)	
Процесс производства	100% прецизионная обработка на ЧПУ (отсутствуют остатки после литья под давлением)	

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Особенность	Детали спецификации для PL-CP267	
Химическая стойкость	Полная стойкость к HF, H ₂ SO ₄ , HNO ₃ , HCl, KOH и органическим растворителям	
Диапазон температур	-200°C до +260°C (-328°F до +500°F)	
Обработка поверхности	Гладкая поверхность с низкой пористостью для минимизации удержания частиц	
Варианты конфигурации	Полная кастомизация (размер пластины, ширина слота, шаг слота, конструкция ручки)	
Совместимость с пластинами	Подходит для пластин 2", 3", 4", 6", 8" и 12", а также нестандартных размеров	
Конструкция стока	Доступны V-образное или U-образное профилирование слотов для оптимизированного стока жидкости	
Фоновые уровни	Специальная обработка для соответствия требованиям содержания металлических примесей ниже уровня ppb	